(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005 年4 月14 日 (14.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/033984 A1

(51) 国際特許分類7: G06F 17/50, H01L 21/82, H03K 19/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/007006

(22) 国際出願日:

2004年5月17日(17.05.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-346185 2003 年10 月3 日 (03.10.2003) 3

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).

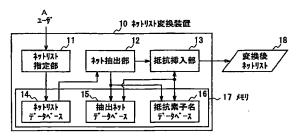
(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 *(*米国についてのみ*)*: 中順一 (NAKA, Junichi). 岡 浩二 (OKA, Koji).
- (74) 代理人: 早瀬 憲一 (HAYASE, Kenichi); 〒5320003 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号ニッセイ新大阪ビル13階 早瀬特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

/続葉有/

(54) Title: NET LIST CONVERSION METHOD, NET LIST CONVERSION DEVICE, STILL-STATE LEAK CURRENT DETECTION METHOD, AND STILL-STATE LEAK CURRENT DETECTION DEVICE

(54) 発明の名称: ネットリスト変換方法、ネットリスト変換装置、静止状態貫通電流検出方法、及び静止状態貫通 電流検出装置



A... USER

- 10... NET LIST CONVERSION DEVICE
- 11... NET LIST SPECIFICATION SECTION
- 12... NET EXTRACTION SECTION
- 13... RESISTOR INSERT SECTION 14... NET LIST DATABASE
- 15... EXTRACTED NET DATABASE
- 16... RESISTOR ELEMENT NAME DATABASE
- 18... NET LIST AFTER CONVERSION
- 17... MEMORY

(57) Abstract: As shown in Fig. 1, a gate terminal or a logic gate input terminal of a MOS transistor contained in a net list to be subjected to leak current detection is extracted. Net list conversion is performed by inserting a resistor between the gate terminal or the logic gate input terminal of the MOS transistor and between the gate terminal or the logic gate input terminal of the MOS transistor and a reference voltage, thereby performing DC analysis so as to detect a MOS transistor in which leak current may be caused. Thus, it is possible to surely detect a leak current which has been difficult to detect in the conventional DC analysis simulation and surely detect a transistor which may cause leak current in the circuit to be subjected to the leak current detection.

(57) 要約: 第1図に示すように、貫通電流検出対象ネットリストに含まれるMOSトランジスタのゲート端子あるいは論理ゲートの入力端子を抽出し、該MOSトランジスタのゲート端子あるいは論理ゲートの入力端子と電源の間、及び該MOSトランジスタのゲート端子あるいは論理ゲートの入力

2005/033984 A1

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書